




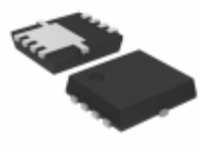
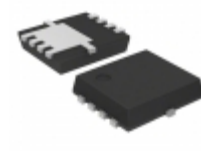


	<h2>RQ3E100MNTB1</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">RQ3E100MNTB1</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">LAPIS Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 10A HSMT8</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">RQ3E100MNTB1.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">RQ3E100MNTB1</a>
Hersteller	<a href="#">LAPIS Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 10A HSMT8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 1mA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-HSMT (3.2x3)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	12.3 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	2W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerVDFN
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	520pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	9.9nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10A (Ta)

RQ3E100MNTB1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, RQ3E100MNTB1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, RQ3E100MNTB1 LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ RQ3E100MNTB1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>RQ3E100MNFU</b> ROHM/ RQ3E100MNFU ROHM/</p>	 <p><b>RQ3E120AT-TB</b> ROHM RQ3E120AT-TB ROHM</p>	 <p><b>RQ3E120AT</b> ROHM RQ3E120AT ROHM</p>	 <p><b>RQ3E100GNFU7TB</b> ROHM RQ3E100GNFU7TB ROHM</p>
 <p><b>RQ3E120ATTB</b> Rohm Semiconductor MOSFET P-CH 30V 12A HSMT8</p>	 <p><b>RQ3E100GNTB</b> Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 30V 10A 8-HSMT</p>	 <p><b>RQ3E100MN</b> ROHM RQ3E100MN ROHM</p>	 <p><b>RQ3E110AJ</b> QQ2850920316 RQ3E110AJ QQ2850920316</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">RQ3E100MNTB1 LAPIS Semiconductor RQ3E100MNTB1 Datenblatt</a>	<a href="#">RQ3E100MNTB1-Datenblätter</a>	<a href="#">RQ3E100MNTB1 PDF</a>	<a href="#">LAPIS Semiconductor RQ3E100MNTB1</a>
<a href="#">RQ3E100MNTB1 Electronic</a>	<a href="#">RQ3E100MNTB1-Komponenten</a>	<a href="#">RQ3E100MNTB1-Verteiler</a>	<a href="#">RQ3E100MNTB1-Bild</a>
<a href="#">RQ3E100MNTB1 Preis</a>	<a href="#">RQ3E100MNTB1 Hersteller</a>	<a href="#">RQ3E100MNTB1 Bild</a>	<a href="#">RQ3E100MNTB1 Aktie</a>
<a href="#">RQ3E100MNTB1 Neu</a>	<a href="#">RQ3E100MNTB1 Original</a>	<a href="#">RQ3E100MNTB1 garantiert</a>	<a href="#">RQ3E100MNTB1 RFQ</a>
			<a href="#">RQ3E100MNTB1-Teil</a>
			<a href="#">RQ3E100MNTB1 Inventar</a>
			<a href="#">RQ3E100MNTB1 Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited